# 小特集 短パルス高強度レーザーによる等積加熱が拓く高エネルギー密度科学 3. 固体密度を超える高密度プラズマの等積加熱の X 線計測

# 3. X-Ray Measurement for Fast Isochoric Heating of High Energy Density Plasma

松 尾 一 輝 MATSUO Kazuki 大阪大学レーザー科学研究所 (原稿受付:2020年6月20日)

キロジュール級の短パルス高強度レーザーの登場により,固体密度以上の物質を等積加熱し,高エネルギー 密度プラズマを生成することが可能となった.また等積加熱を再現するプラズマシミュレーションの発展によ り,ひとくちに等積加熱といっても,そこには複数の加熱機構が組み合わさっていることがわかってきた.等積 加熱という複雑な加熱機構の解明に迫るためには,ある密度のプラズマをどれだけの温度まで加熱できたかとい う,加熱の結果を正確に測定するだけでは不十分である.複数の加熱機構がどのような割合で起こっているのか といった,加熱機構の解明に迫ることのできる計測方法の確立が必要となる.本章では,等積加熱によって生成 された keV 温度・固体密度以上のプラズマを特徴づけ,等積加熱の加熱機構の解明に迫ることができる,ドープ ターゲットを用いたX線スペクトル計測,発光分布計測について重点的に解説する.

### Keywords:

picosecond relativistic laser, isochoric laser heating, high energy density plasma, x-ray spectroscopy, x-ray imaging

# 3.1 はじめに

前章でも述べられたように、レーザー強度 10<sup>18</sup> W/cm<sup>2</sup> を超える高強度短パルスレーザーを用いることで、密度を 固体に近い状態に維持したまま物質を"等積加熱"し、非常 に高い圧力状態を作り出すことが可能である.この等積加 熱は加熱の対象となるプラズマの密度やレーザーのパラ メータ等に大きく依存する.本章ではレーザーのエネル ギーがキロジュールを超えるような大型の短パルス高強度 によって等積加熱された固体密度以上のプラズマの計測に ついて取り上げる.

大阪大学レーザー科学研究所の激光 XII 号レーザーを用 いてプラズマを固体密度以上に圧縮し,キロジュール級の 短パルス LFEX レーザーを用いて圧縮したプラズマを加熱 することで,太陽内部の圧力に匹敵するギガバール(keV 温度・固体密度以上のプラズマに相当)を超える高エネル ギー密度のプラズマ生成が達成されている[1].そのよう なプラズマを地上に作り出すことができれば,地上にいな がら星内部の物性を研究するといった宇宙物理などの学術 研究の進展,高輝度 X 線源など将来の応用が期待される線 源の開発,究極的には核融合などの応用研究の展開が可能 となるため,精力的な研究が現在も進められている[2].

レーザーで加熱された高エネルギー密度プラズマの温 度・密度の見積もりには、高密度プラズマ中で減衰するこ となく外部に放射されるX線や中性子の観測が主に用いら れてきた[3].特に, 外部から照射した透過X線の観測, およびプラズマから発生する自発光X線の計測,中性子の イールド計測はプラズマの情報を正確に反映しており,加熱の結果を計測するには有効な手段として認知されている.

近年,等積加熱を再現するプラズマシミュレーション [4]の発展により,高強度レーザーによる等積加熱の加熱 機構は,レーザーによって加速された高速電子と物質が衝 突電離する直接衝突加熱(drag heating),レーザー照射面 近傍で高速電子群によって引き起こされる電流による電気 抵抗性加熱(resistive heating),照射面近傍で加熱された プラズマの熱エネルギーが拡散的に固体内部に侵入してい く熱拡散加熱(diffusive heating)といった複数の加熱機構 が組み合わさっていることがわかってきている.従来から 行われてきたような,加熱の結果を正確に測定する手法だ けでは計測によって,等積加熱の複雑な物理機構に迫るこ とは難しい.

本章では,等積加熱によって生成された keV 温度・固体 密度以上のプラズマを特徴づけ,等積加熱の加熱機構の解 明に迫ることができるドープターゲットを用いた X線スペ クトル計測,発光分布計測の手法について重点的に解説す る.

# 3.2 X線計測のためのドープターゲットの開発

等積加熱の加熱機構に迫るために,keV 温度まで加熱さ れることによって電離し,特徴的な輝線 X 線を発生するト レーサーとなる物質をあらかじめレーザー照射の標的とな るターゲットにドープしておくことで,トレーサーとなっ

Institute of Laser Engineering, Osaka University, Suita, OSAKA 565-0871, Japan

author's email: matsuo-k@ile.osaka-u.ac.jp

た物質の原子から発生する X 線を計測し, 現象の理解を進める手法が有用である.

レーザーによって加速された高速電子と電離前のトレー サー物質が衝突電離し,直接衝突加熱が起きる際に,ト レーサー原子は Ka線と呼ばれる特性 X線を放出する.分 光器を用いてターゲットから発生した X線をスペクトル分 解し,Ka線の絶対量を計測することで,直接衝突加熱に よって何%のレーザーエネルギーがプラズマの加熱に寄与 したかという効率を算出し,その発光分布を計測すること で直接衝突加熱がターゲットのどのあたりで優位におきた かを計測することが可能である.

また等積加熱によってターゲットの加熱が進み,トレー サー物質の電離が進んでいくと,トレーサー原子は各電離 状態に応じて Li-like サテライト線, Hea 線といった共鳴線 を放出する.X線をスペクトル分解し,各共鳴線の強度比 を計測することで,プラズマの電子温度を同定することが 可能である.

ターゲットにドープするトレーサーは対象となるプラズ マの電子温度から判断される.例えば銅の原子は,図1の ように500 eVから2 keVの範囲で,Hea 線を放出するヘリ ウム様にまで電離された原子や,Li-like サテライト線を放 出するリチウム様の原子の存在比が変わっていく.この比 は Hea 線とLi-like サテライト線の強度比に対応しており 500 eV から2 keV 程度のプラズマであれば,これらのスペ クトルの強度比からプラズマの電子温度を計測することが 可能である.一般的にトレーサーの原子番号が大きいほ ど,ヘリウム様などの高電離状態まで電離が進みづらいた め,500 eV から2 keV よりも温度の高いプラズマの温度を Hea 線とLi-like サテライト線の強度比で計測する場合 は,より原子番号の大きいトレーサーが適している.

上記で述べた計測には、従来から行われてきた X 線のス ペクトル、イメージング計測の発展に加えて、ドープター ゲットを高精度に形作る技術が不可欠である.また近年 は、様々なターゲットデザインが実験に用いられるように なったことから、ターゲット作製も幅広いアプローチの技 術が求められるようになってきた.図2は高強度レーザー によって圧縮したプラズマを等積加熱することで keV 温



図1 プラズマの電子温度と銅の各電離状態の存在比.



図2 (a)オレイン酸銅ターゲットと(b)D<sub>2</sub>O液体ドープターゲットの写真.

度・固体密度以上の状態を達成するために,2つの異なる 方法で製作された実験用ターゲットの写真である.レー ザー照射の標的となる球形のターゲットにレーザーガイド 用の金コーンが取り付けられた形状をしている.これらの ターゲット製作技術について以下の項でその概要を紹介す る.

### 3.2.1 オレイン酸銅ターゲット

ドープターゲットを高精度に形作る技術の一つとして, エマルション法を用いて銅のトレーサーを含有した中実球 ターゲットの開発が行われた[5].この方法ではまず銅を 化学的に含んだオレイン酸銅[Cu(C18H33O2)2]と有機溶媒 としてベンゼン,ジクロロエタンを混ぜ合わせ,オレイン 酸銅溶液を作る.次に,ガラス毛細管マイクロ流体デバイ スを使用して,ポリビニルアルコール (PVA)中にオレイ ン酸銅の液滴 (エマルション)を生成する.オレイン酸銅 溶液とPVAの流量をコントロールすることで,中実球の 直径をコントロールすることができる.その後,エマル ションをロータリーシェーカーにセットし,2~3日間攪 拌して,有機溶媒を除去する.これにより,オレイン酸銅 の中実球をエマルションから得ることができる.

エマルション法で作られたこの中実球はX線計測に十分 な原子比で 0.93% の銅を含み,測定された球の最大半径と 最小半径の差が球の平均半径に対して 3%という良好な真 球度を示した.この中実球ターゲットをレーザーによって 圧縮し,高強度レーザーによって等積加熱することで, keV 温度・固体密度以上の高エネルギー密度のプラズマを 生成し,プラズマから発生する X線を計測することで,等 積加熱の加熱機構の解明に迫ることができる.またこの研 究では,実験側からの要求により,溶質としてオレイン酸 銅が選択されたが,異なる溶質を選択することにより,ト レーサーとなる物質の種類や濃度を変更することができる ため,このターゲット製作技術は今後幅広い実験で応用さ れていくと期待される.

### 3.2.2 D<sub>2</sub>O液体ドープターゲット

等積加熱の加熱機構に迫るためには、銅などの原子をト レーサーとしてドープしておき、その原子から発生する X 線を計測することによって現象の理解を進める手法が有用 である一方で、慣性閉じ込め核融合では、重水素とトリチ ウムを含む燃料ターゲットを使用し、それらの核融合反応 で生成される中性子のイールドを測定することで、プラズ マの質量面密度(g/cm<sup>2</sup>),イオン温度を計測している.X 線計測のためのトレーサーに加えて,重水素とトリチウム を含んだターゲットを開発することができれば,等積加熱 の加熱機構に迫る計測と核融合反応の計測つまり,加熱の 過程と結果を同時に測定することが可能となり,慣性核融 合の実験用ターゲットとして極めて有用である.

上記のような要求から、ポリスチレンカプセルの中に銅 などのトレーサー材料に加えて重水素、トリチウムを含ん だ溶液が封入されたターゲットの製作方法が開発された [6]. この方法ではまず、ポリスチレンのカプセルにフェ ムト秒レーザーを照射して、直径 20 µm 程度の穴を開け る.ターゲットの最終的な直径はこの時使用するポリスチ レンのカプセルによって決定される.次にガラスキャピラ リーを穴に通し、そのキャピラリーを通して X線トレー サー材料を含む溶液(銅を X線トレーサーとする場合は CuCl<sub>2</sub>の溶液を使用)と D<sub>2</sub>O溶液をカプセルに充填する. X 線トレーサー材料を含む溶液とD<sub>2</sub>O溶液の配合を変えるこ とで、最終的にターゲットに含まれることになる X線ト レーサーの含有量をコントロールすることができる.

X線トレーサー材料を含む  $D_2O$  液体で満たされたター ゲットが  $T_2O$  雰囲気下に置かれると、ポリスチレンは  $D_2O$ および  $T_2O$  に対してわずかに透過性があるため、 $D_2O$  は  $T_2O$  に交換され、ポリスチレンのカプセル内で完全に混合 される.この  $T_2O$  の置換システムは、 $T_2O$  の代わりに  $H_2O$ を使用してテストされ、約50%の  $D_2O$  が置換されたことが 確認された.このターゲットは、実際の実験では使用され てはいないものの、将来の核融合実験で導入される予定で ある.

### 3.3 等積加熱のダイナミクスに迫る X 線計測

本節では,前節で紹介したターゲットをレーザーで圧縮 後,等積加熱し,ターゲットに含まれるトレーサーから発 生する X 線を計測した結果について概説することで,等積 加熱という複雑な物理機構に迫っていく.本実験は,大阪 大学レーザー科学研究所の激光 XII 号レーザー及び LFEX レーザーを用いて行われた[1].計測は,対象となるプラズ マに関する物理的描像があって初めて意味のあるものとな る.そのような視点を踏まえ,まず等積加熱の物理的描像 について簡単に振り返る.

等積加熱には、図3に示したように3つの主要なメカニ ズムがあることが知られている。右辺の最初の項は直接衝 突加熱の項である。高強度レーザーとプラズマが相互作用 することで高速の電子がレーザー進行方向に加速される。 高速電子の経路長(L)に沿ったコアの質量面密度 ( $\rho$ L)が高速電子を止めるのに十分である場合(1 MeV の 高速電子に対しておおよそ $\rho$ L=0.6 g/cm<sup>2</sup>が要求され る)、この高速電子の衝突によるプラズマの直接加熱は優 位なものとなる。

レーザー進行方向に高速電子流が流れるとプラズマは電 荷中性を保とうとするため,高速電子の進行方向とは逆の 流れを持つ電流(リターン電流)が駆動される.リターン 電流は高速電子よりも平均速度が遅く,周りのプラズマと



図3 等積加熱の機構の概要図.

衝突しやすいため、リターン電流はプラズマをオーム加熱 する.これを抵抗性加熱と呼び、特に高速電子の電流密度 が高い場所であるレーザーとプラズマの相互作用領域にお いて支配的な加熱メカニズムである.

抵抗性加熱によってレーザーとプラズマの相互作用領域 が高温になると、背景の電子たちによってこの高温領域の 熱エネルギーは低温で密度の高い領域に拡散的に輸送され ていく.これを拡散加熱と呼び、レーザーによって高温領 域が保たれ続ける限り、高温領域の熱エネルギーは連続的 に密度の高いプラズマに供給され続ける.

これまでの研究では、上記で述べた直接衝突加熱の研究 がkeV温度・固体密度以上のプラズマを対象に行われてき た.ドープターゲットを用いた X 線スペクトル計測,発光 分布計測を行うことで、等積加熱によって生成された keV 温度・固体密度以上のプラズマを特徴づけたことで、直接 加熱だけではなく拡散加熱も、固体密度以上のプラズマを keV温度を超えて加熱するために重要であることがわかっ てきた[1,7].

### 3.3.1 X線スペクトル計測による加熱機構の解明

実験では、オレイン酸銅中実球ターゲットを圧縮後、ピコ秒の高強度レーザーで加熱し、銅の輝線スペクトルを結晶型のX線分光器で取得した.図4は銅のトレーサーから発生した、8.0から8.6 keVの範囲のX線スペクトルを示している.8.05、8.35、および8.39 keVのピークは、それぞれCu-Ka線、Li-likeCuサテライト線、およびCu-Hea線という名前がついている.

Cu-Ka線は高強度レーザーで加速された高速電子が中性 (電離していない)の銅のK殻から電子を励起し,その緩和 過程で発生する特性 X線である.Ka線の絶対量はレー ザーによって加速された高速電子と圧縮されたプラズマの 衝突の効率,つまり直接衝突による加熱の効率を表してい る.Li-like Cuサテライト線とCu-Hea線はそれぞれリチウ ム様,へリウム様まで電離された銅のK殻から電子が励起 されることで発生する X線スペクトルである.プラズマの 電子温度によって銅の各電離状態の存在比が変わるため, この強度比は,主にプラズマの電子温度,また分光器の視 Special Topic Article



線に沿ったプラズマの厚さおよび密度に関する情報を反映 している.

X線スペクトル計算コード FLYCHK の計算結果から実 験で取得したLi-like Cuサテライト線とCu-Hea線の強度比 を,別途計測されたプラズマの密度の範囲で再現するスク リプトを作成し解析を行い,加熱されたターゲットの温度 を決定した.測定値はプラズマを最大 2.2 keV まで加熱し, 太陽内部に匹敵する22ギガバールも高圧力プラズマが生成 されていることを示していた.また Cu-Ka線の絶対量から 直接衝突加熱による加熱効率も別途見積もられた[8].直 接衝突加熱による最大結合効率は7.7%であり,これは直 接衝突加熱によってプラズマが最大 80 eV まで加熱された ことを示している.直接衝突加熱だけでは上記で達成され た keV 温度を超えるプラズマの生成を説明できない.これ は直接衝突加熱以外の,他の加熱メカニズムも加熱に寄与 していることを示唆している.

# 3.3.2 フレネルフェーズゾーンプレートを用いた加熱領 域の可視化

加熱領域の特定のために,等積加熱された高エネルギー 密度プラズマの二次元加熱分布をフレネルフェーズゾーン プレート (FPZP) によって測定した.FPZP はタンタルや 金などの金属で構成されたマルチリング形状をしており, 入射してきた X 線がそのリング上で回折をおこすこと で,結像点で X 線の強めあいが起こり,像が結ばれる. 図5に示すように,トレーサーから放出された Ka 線と Hea 線がそれぞれ FPZP によって画像化され,加熱領域が 特定された.Ka 線はターゲットの端で強く観察される一 方で,加熱領域である Hea 線の発光がレーザー軸に沿って 強く観察された.この発光領域の違いは,コアがレーザー 軸に沿って局所的に加熱されていることを示している.

3.3.3 2次元 PIC シミュレーションによる等積加熱の計算 この加熱の物理的描像にせまるため、加熱実験で得られ た密度分布を使用して、2次元の粒子内セル (PIC) シミュ レーション (PICLS) による計算を行った.図6は圧縮し



図5 Kα 線と Heα 線の発光分布.参考文献[1]補足資料の図 S 3を引用.



図6 1 keV の等温線の時間発展.レーザー照射側(右側)からコ アの中心に向かって1 keV 以上の温度の領域が拡散してい く.

たプラズマをピコ秒の高強度レーザーで直接加熱した際 に、1 keV 以上の温度領域が広がっていく様子を示したシ ミュレーション計算結果である.抵抗性加熱によってレー ザーとプラズマの相互作用領域でプラズマが加熱され、そ の周囲に熱波が秒速数千キロメートルで拡散的に広がって いく様子を見ることができる.熱波は、加熱レーザー照射 が終了した後も 10 μm/ps を超える速度で伝播し、レー ザーのピークから 4.8 ps 後には、圧縮された密度の高い領 域 (X>-40 μm)が1 keV以上の電子温度まで加熱された. この PIC シミュレーションは、拡散加熱が keV 温度を超え て高密度領域を局所的に加熱できる加熱プロセスであるこ とを明らかにした.

# 3.4 まとめと展望

本章では,等積加熱によって生成された keV 温度・固体 密度以上のプラズマを特徴づけ,等積加熱の加熱機構の解 明に迫ることができるドープターゲットを用いたX線スペ クトル計測,発光分布計測の手法について重点的に解説し た.従来から行われてきた中性子のイールド計測のように 加熱の結果を正確に測定する手法に加えて,ドープター ゲットを用いたX線スペクトル計測,発光分布計測を行っ ていくことで,より深く等積加熱の複雑な物理機構に迫る ことができる.今後は,このX線スペクトル計測,発光分 布計測に時間分解計測を組み合わせて,等積加熱の物理機 構により詳細にアプローチしていこうと考えている.

# 謝 辞

激光 XII 号レーザー及び LFEX レーザーを利用した実験 に関して,大阪大学レーザーエネルギー学研究所の多くの 職員,学生の方々に感謝いたします.特に X 線の計測に関 しては,大阪大学レーザー科学研究所の李昇浩博士,坂田 匠平博士,藤岡慎介教授,ネバダ大学の澤田寛准教授がい なければ遂行することができませんでした,感謝いたしま す.またターゲット開発並びに製作に関して,大阪大学 レーザー科学研究所の有川安信講師,産業技術総合研究所 の岩佐祐希博士にご尽力いただきました,感謝いたしま す.また等積加熱の理論及びシミュレーションに関して

- は、大阪大学レーザー科学研究所の東 直樹氏、岩田夏弥講
- 師,千徳靖彦教授にご尽力いただき感謝いたします.

# 参 考 文 献

- [1] K. Matsuo et al., Phys. Rev. Lett. 124, 35001 (2019).
- [2] 千徳靖彦: プラズマ・核融合学会誌 95,6 (2019).
- [3] 重森啓介: プラズマ・核融合学会誌 92,3 (2016).
- [4] Y. Sentoku and A.J. Kemp, J. Comp. Phys. 227, 6846 (2008).
- [5] Y. Iwasa *et al.*, Fusion Eng. Des. **125**, 89-92 (2017).
- [6] Y. Arikawa et al., Fusion Sci. Technol. 76, 464 (2020).
- [7] H. Sawada et al., Phys. Rev. Lett. 122, 155002 (2019).
- [8] S. Sakata et al., Nat. Commun. 9, 3937 (2018).